

DHA<sup>®</sup>

QJ/DHA 09.29-2018

LD640

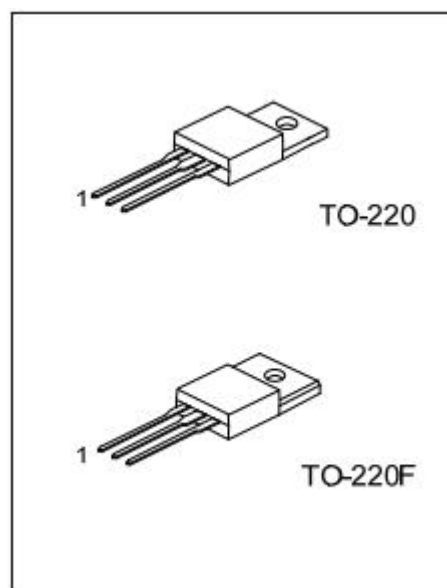
## N-沟道 MOSFET 功率晶体管

## 描述

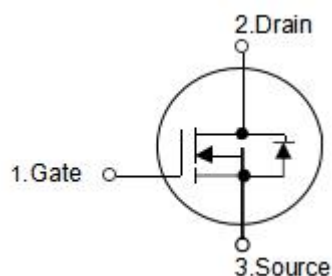
N 沟道 MOSFET 采用塑料 TO220 封装。符合 RoHS。

## 用途

适用于高速开关, 不间断电源, 电机控制, 音频放大器, 工业执行器。用于电信, 工业和消费者环境的 DC-DC 和 DC-AC 转换器。



## 等效电路图

电参数 (T<sub>amb</sub> = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV <sub>DSS</sub>	漏极-源极 击穿电压	V	200	-	-	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>D</sub>	漏极连续电流	A	-	-	18.0	T <sub>j</sub> = 25 °C
R <sub>DS(on)</sub>	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.155	0.18	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 9 A
V <sub>GS(th)</sub>	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>DSS</sub>	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	1	V <sub>DS</sub> = 200 V, V <sub>GS</sub> = 0 V
I <sub>GSS</sub>	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V <sub>GS</sub> = ± 25 V, V <sub>DS</sub> = 0 V
T <sub>j</sub>	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	°C				

丹东华奥电子有限公司

<http://www.huaoe.com>